



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS649A

对应国外型号
2SB649A

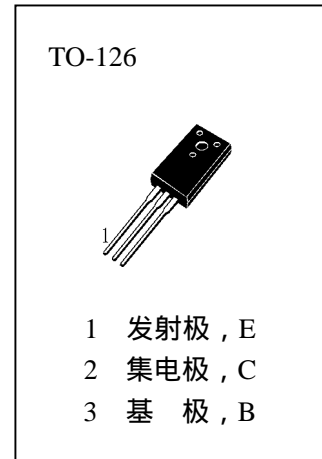
主要用途

低频功率放大

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	20W
P_C	——集电极功率耗散 ($T_A=25$)	1W
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	-180V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	-160V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	-5V
I_C	——集电极电流.....	-1.5A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-180			V	$I_C=-1mA, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-1mA, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	$V_{CB}=-160V, I_E=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	60		200		$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
$H_{FE}(2)$	直流电流增益	30				$V_{CE}=-5V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-1	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
V_{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
C_{ob}	共基极输出电容		27		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

分档及其标志

B

C

60—120

100—200